



X-FAB 增强其 180nm 高压 CMOS 技术产品组合中的 车用嵌入式闪存产品

中国北京, 2021年4月15日——全球公认的卓越的模拟/混合信号与光电半导体解决方案晶圆代工厂 X-FAB Silicon Foundries (“X-FAB”) 今日宣布, 已为其 XP018 高压 (HV) 车用产品工艺推出全新闪存功能。这款新的闪存 IP 利用 X-FAB 得到广泛验证的氮化硅氧化物 (SONOS) 技术——该技术具备更高的性能水平和一流的可靠性, 完全符合严格的 AEC100-Grade 0 汽车规范, 可承受在 -40°C 至 175°C 的温度范围内工作, 并完全支持 ISO 26262 规定的功能安全级别。其阵列大小为 32KB, 采用 8K×39 位配置, 带有 32 位数据总线; 另外 7 位专用于错误代码校正 (ECC), 以确保零缺陷的现场可靠性。

X-FAB 专有的 XSTI 嵌入式非易失性存储器 (NVM) IP 测试接口也已包括在内, 以达成对存储器的完全串行接驳。

该款汽车级闪存 IP 能够运行于单个 1.8V 电源, 非常适用于低功耗设计。新增的内置自检 (BIST) 模块对于实现有效的存储器测试以及全面的产品调试至关重要。如需要, X-FAB 还可以为客户带来完整的 NVM 测试服务。

“这一全新 IP 解决方案进一步丰富了 X-FAB 针对 180nm 开放技术平台的嵌入式闪存产品组合; 该平台具有多种电压与晶圆材料可供选择, 扩大了我们向市场提供的产品阵容, 使我们能够满足客户在更多应用中的需求。” X-FAB 公司 NVM 开发总监 Thomas Ramsch 表示, “在低功耗和需要适应挑战性环境的情况下, 它将具有特殊的价值。”

“在现有 X-FAB 平台上增加的全新嵌入式闪存功能, 将实现更小的面积占比, 从而为我们的客户带来更明显的收益。此外, XP018 的模块化方法意味着其仅需要更少的掩膜层。这两个因素都将有助于推动晶片成本的显著优化。” X-FAB 公司 NVM 解决方案技术营销经理 Nando Basile 补充道, “全新闪存 IP 意味着 XP018 现在能够以高度经济高效的方式应对需要额外逻辑内容和计算资源的混合信号及高压等应用。这将特别适用于电池供电的设备, 如便携式或自主智能传感器; 并在医疗保健、工业、消费和物联网领域发挥巨大潜力。”

###

缩略语:

BIST	内置自检
ECC	错误代码校正
HV	高压
IP	知识产权
NVM	非易失性存储器
SONOS	氮化硅氧化物

关于 X-FAB:

X-FAB 是领先的模拟/混合信号和 MEMS 晶圆代工集团, 生产用于汽车、工业、消费、医疗和其它应用的硅晶圆。X-FAB 采用尺寸范围从 1.0 μ m 至 130nm 的模块化 CMOS 和 SOI 工艺, 及其特色 SiC 与微机电系统 (MEMS) 长寿命工艺, 为全球客户打造最高的质量标准、卓越的制造工艺和创新的解决方案。X-FAB 的模拟数字集成电路 (混合信号 IC)、传感器 MEMS 在德国、法国、马来西亚和美国的六家生产基地生产, 并在全球拥有约 3,800 名员工。 www.xfab.com

欢迎扫码关注 X-FAB 官方微信公众号, 了解更多精彩资讯:



媒体联系:

王伟
X-FAB 中国区市场经理
86-21-2050 1645
Angela.Wang@xfab.com

乔治
GeoMatrix Public Relations Ltd.
86-10-8595 9439
george.qiao@geomatrixpr.com